

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 多数の単位画素を有するイメージセンサにおいて、

各単位画素は、

入射光を感知して光電荷を生成する光感知手段と、
前記光電荷を感知ノードに伝送する伝送手段と、
前記光感知手段内に完全空乏領域を生成させ電源電圧を前記感知ノードに供給することにより、前記感知ノードをリセットさせる第 1 リセット手段と、
前記感知ノードがリセットされる時に前記光感知手段に生成された過剰電荷を電源ラインに伝送する第 2 リセット手段とを備えていることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項 2】 前記感知ノードの電圧レベルを増幅して、その増幅された信号を生成する増幅手段と、
スイッチング動作を遂行して前記増幅された信号を出力端に出力するスイッチング手段とをさらに備えていることを特徴とする請求項 1 に記載のイメージセンサ。

【請求項 3】 前記伝送手段は、前記光感知手段と前記感知ノードとの間に連結されたものであることを特徴とする請求項 1 に記載のイメージセンサ。

【請求項 4】 前記第 1 リセット手段は、前記感知ノードと前記電源ラインとの間に連結されたものであることを特徴とする請求項 3 に記載のイメージセンサ。

【請求項 5】 前記第 2 リセット手段は、前記光感知手段と前記電源ラインとの間に連結されたものであることを特徴とする請求項 4 に記載のイメージセンサ。

【請求項 6】 前記光感知手段は、フォトダイオードであることを特徴とする請求項 5 に記載のイメージセンサ。

【請求項 7】 前記伝送手段は、nMOS トランジスタであることを特徴とする請求項 6 に記載のイメージセンサ。

【請求項 8】 前記第 1 及び第 2 リセット手段は、nMOS トランジスタであることを特徴とする請求項 7 に記載のイメージセンサ。

【請求項 9】 前記第 2 リセット手段のしきい電圧が前記第 1 リセット手段のしきい電圧より低いことを特徴とする請求項 8 に記載のイメージセンサ。

【請求項 10】 前記フォトダイオードは、第 1 伝導型の半導体基板と、
前記第 1 伝導型の半導体基板上に形成された第 2 伝導型の第 1 ドーピング領域と、
該第 1 ドーピング領域上に形成された第 1 伝導型の第 2 ドーピング領域とを備えていることを特徴とする請求項 9 に記載のイメージセンサ。

【請求項 11】 前記第 2 ドーピング領域のチャネル領域が、第 1 ドーピング領域と直接連結されていることを特徴とする請求項 10 に記載のイメージセンサ。

【請求項 12】 前記第 2 ドーピング領域が、前記半導

体基板と接触していることを特徴とする請求項 11 に記載のイメージセンサ。

【請求項 13】 前記第 1 伝導型が p 型であり、前記第 2 伝導型が n 型であることを特徴とする請求項 12 に記載のイメージセンサ。

【請求項 14】 前記半導体基板は、前記半導体基板上に形成され、半導体基板の不純物濃度より低い不純物濃度を有するエピタキシャル層をさらに備えていることを特徴とする請求項 10 に記載のイメージセンサ。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明が属する技術分野】 本発明は、イメージセンサに関し、特に、ブルーミング効果を防止できる多数の単位画素を有するイメージセンサに関する。

【0002】

【従来の技術】 周知のように、イメージセンサは、物体から反射される光を感知してイメージデータを生成する装置である。特に、CMOS (complementary metal oxide semiconductor) 技術を利用して製造されたイメージセンサを CMOS イメージセンサという。

【0003】 一般に、CMOS イメージセンサは、多数の単位画素を含んでおり、各単位画素は、一つの光感知素子と多数のトランジスタとからなる。フォトダイオードのような光感知素子は、物体から反射される入射光を感知して光電荷を蓄積し、トランジスタは蓄積された光電荷の伝送を制御する。

【0004】 図 1A は、CMOS イメージセンサに含まれた従来の単位画素を示す回路図である。ここで、符号 160 は、単位画素の出力信号を安定化させる役割をする負荷トランジスタである。図 1B は、図 1A に示した従来の単位画素に対するレイアウトを示す図面である。

【0005】 図示したように、従来の単位画素は、一つのフォトダイオード 110 と四つの nMOS トランジスタとからなる。四つの nMOS トランジスタは、それぞれ伝達トランジスタ 120、リセットトランジスタ 130、増幅トランジスタ 140、及びスイッチングトランジスタ 150 の機能を備えている。

【0006】 フォトダイオード 110 は、入射光を感知して光電荷を生成する。伝達トランジスタ 120 は、感知ノード Ns に連結されており、伝達制御信号 TX に応答して光電荷を感知ノード Ns に伝達する。

【0007】 リセットトランジスタ 130 は、感知ノード Ns に連結されており、リセット制御信号に応答してフォトダイオード 110 内に完全空乏領域を形成させ、リセット電圧を感知ノードに供給する。増幅トランジスタ 140 は、感知ノード Ns の電圧レベルを増幅して増幅された信号 (DX) を生成する。スイッチングトランジスタ 150 は、増幅トランジスタ 140 と出力端 Nout とに連結されており、スイッチング制御信号 SX に応答してスイッチング動作をすることによって出力端 Nout

tを介して増幅された信号をイメージデータとして出力する。

【0008】四つのnMOSトランジスタの中で、電荷伝達効率を向上させ、イメージデータの電圧損失または電圧降下を減少させるために、伝達トランジスタ120及びリセットトランジスタ130は、空乏モード(depletion mode)nMOSトランジスタまたは低いしきい電圧を有するネガティブnMOSトランジスタで具現されている。

【0009】かかる単位画素で、感知ノードNsをリセットさせる過程は、伝達トランジスタ120及びリセットトランジスタ130により行われるため、飽和領域で過剰電荷の経路は、伝達トランジスタ120及びリセットトランジスタ130から電源ラインVDDに形成されるべきである。従って、伝達トランジスタ120及びリセットトランジスタ130の電圧障壁に対する制御が極めて重要である。もし、伝達トランジスタ120とリセットトランジスタ130のいずれか一つでも正しく制御されなければ、過剰電荷は、隣接した単位画素に流れることになって誤動作を誘発することとなる。かかる現象をブルーミング効果(blooming effect)という。

【0010】ブルーミング効果によって、正確なイメージデータを獲得することが困難になり、CMOSイメージセンサの光感度を低下させるという問題点がある。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した問題点を解決するために案出されたものであり、ブルーミング効果を抑制または防止することにより、光感度を増大させることのできるイメージセンサを提供することによる目的がある。

【0012】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明のイメージセンサは、多数の単位画素を備えており、各単位画素が、入射光を感知して光電荷を生成する光感知手段と、前記光電荷を感知ノードに伝送する伝送手段と、前記光感知手段内に完全空乏領域を生成させ電源電圧を前記感知ノードに供給することにより該感知ノードをリセットさせる第1リセット手段と、前記感知ノードがリセットされる時に前記光感知手段に生成された過剰電荷を電源ラインに伝送する第2リセット手段とを備えていることを特徴としている。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を容易に実施できる程度に詳細に説明するため、本発明の好ましい実施の形態を、添付した図面を参照して説明する。

【0014】図2Aは、本発明に係るCMOSイメージセンサに含まれている単位画素を示す回路図である。符号260は、単位画素の出力信号を安定化させるために用いられる負荷トランジスタを示す。図2Bは、図2A

に図示した単位画素のレイアウトを示す図面である。

【0015】図2Aを参照すれば、本発明に係る単位画素は、光感知素子として一つのフォトダイオード210と制御手段としての五つのnMOSトランジスタとからなる。五つのnMOSトランジスタとは、伝達トランジスタ220、第1リセットトランジスタ230A、第2リセットトランジスタ230B、増幅トランジスタ240、及びスイッチングトランジスタ250である。

【0016】フォトダイオード210は、入射光を感知して光電荷を生成する。伝達トランジスタ220は、フォトダイオード210と感知ノードNsとの間に連結されて、伝達制御信号TXに応答して光電荷を感知ノードNsに伝達する。

【0017】第1リセットトランジスタ230Aは、感知ノードNsと電源ラインVDDとの間に連結されて、リセット制御信号RXに応答してフォトダイオード210内に完全空乏領域を形成させ、リセット電圧を感知ノードNsに供給することにより、リセット動作を遂行する。

【0018】第2リセットトランジスタ230Bは、フォトダイオード210と電源ラインVDDとの間に連結されて、フォトダイオード210で生成された過剰電荷を電源ラインVDDに伝達する。この場合、第2リセットトランジスタ230Bのしきい電圧を、第1リセットトランジスタ230Aのしきい電圧より低く形成することによって、過剰電荷が電源ラインVDDに容易に伝達されるようにする。

【0019】増幅トランジスタ240は、感知ノードNsの電圧レベルを増幅して増幅された信号(DX)を生成する。スイッチングトランジスタ250は、増幅トランジスタ240と出力端Noutとの間に連結されて、スイッチング制御信号SXに応答してスイッチング動作をすることによって出力端Noutを介して増幅された信号をイメージデータで出力する。

【0020】図2Bに図示したように、第1リセットトランジスタ230AのゲートG1と第2リセットトランジスタ230BのゲートG2とは、同一の導電層に連結されている。

【0021】図3A及び図3Bは、それぞれ、図2Bに示したA'-A線とA''-A線により切断した断面図である。図3A及び図3Bを参照すれば、本発明に係るフォトダイオード210は、半導体基板301上にn型ドーピング領域302及びp型ドーピング領域303を順に形成することによって提供される。また、伝達トランジスタ220のように、第2リセットトランジスタ230Bのチャネル領域がフォトダイオード210のn型ドーピング領域302と直接的に連結されている。

【0022】半導体基板301は、p型基板上にp型エピタキシャル層を形成することによって提供されるのが好ましい。この場合、p型エピタキシャル層の不純物濃

度は、p型基板の不純物濃度より低くする。また、p型ドーピング領域303が半導体基板301と直接的に接触するように形成することによって、5Vまたは3.3ないし2.5Vの電源電圧でも、完全空乏領域がフォトダイオード内に形成されるようにすることができる。

【0023】図4は、リセット動作後の単位画素の電位を示す図面である。図面から分かるように、第2リセットトランジスタ230Bのしきい電圧が第1リセットトランジスタ230Aのしきい電圧より低いため、過剰電荷401が電源ラインVDDに容易に伝達されてブルーミング効果を防止でき、CMOSイメージセンサの光感度が向上する。

【0024】本発明の技術思想を上記好ましい実施例によって記述したが、請求項で限定した本発明の範囲内で、種々の変更、追加及び置換が可能であることは当業者において明白である。

【0025】

【発明の効果】本発明のイメージセンサは、従来の単位画素構造に一つのリセットトランジスタが追加されており、フォトダイオードが容易に完全空乏化され、またフォトダイオードで生成された過剰電荷の隣接単位画素への移動が抑制されるようになっている。そのために、光感度の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1A】 CMOSイメージセンサに含まれている従来の単位画素を示す回路図である。

【図1B】 図1Aに示した単位画素のレイアウトを示す図面である。

【図2A】 本発明に係るCMOSイメージセンサに含まれている単位画素を示す回路図である。

【図2B】 図2Aに示した単位画素のレイアウトを示す図面である。

【図3A】 図2BにおけるA'-A線断面図である。

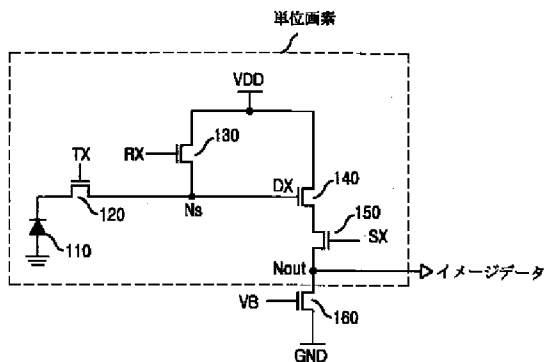
【図3B】 図2BにおけるA''-A線断面図である。

【図4】 リセット動作における、単位画素の電位を示す図面である。

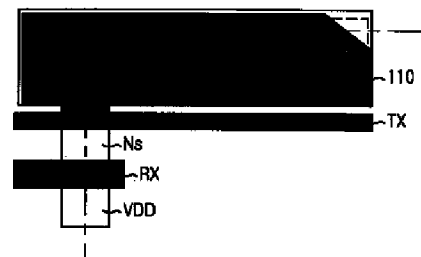
【符号の説明】

- 210 フォトダイオード
- 220 伝達トランジスタ
- 230A 第1リセットトランジスタ
- 230B 第2リセットトランジスタ
- 240 増幅トランジスタ
- 250 スイッチングトランジスタ
- 302 n型ドーピング領域
- 303 p型ドーピング領域

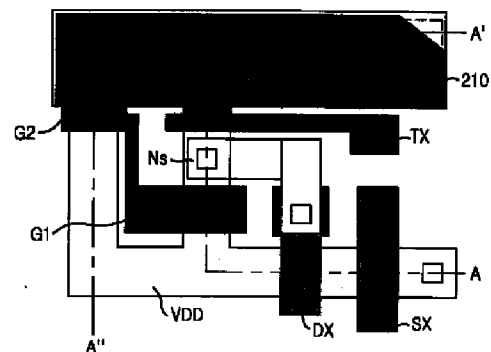
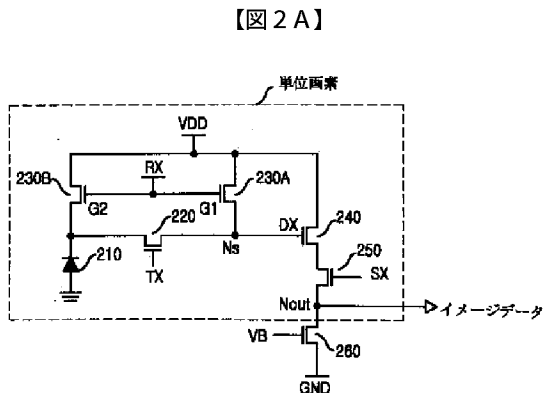
【図1A】



【図1B】



【図2A】



[illegible]